

2011 年 1 月 12 日

瑞萨电子新型 RJK60S5DPK 功率 MOSFET 的主要规格

- 源极电压 (V_{DS})
 - 600 V
- 栅源电压 (V_{GS})
 - 30 V
- 漏极电流 (I_D)
 - 20 A
- 静态漏源通态电阻 ($R_{DS(on)}$)
 - 典型值 150 m Ω ($I_D = 10$ A, $V_{GS} = 10$ V)
- 栅漏电荷 (Q_{gd})
 - 典型值 6 nC ($I_D = 10$ A, $V_{GS} = 10$ V)
- 栅源夹断电压 ($V_{GS(off)}$)
 - 3 V to 5 V
- 沟道温度 (T_{ch})
 - +150 deg C
- 封装
 - TO-3PSG